

XXIV. Erfahrungsaustausch - Mühlleithen Oberflächentechnologie mit Plasma- und Ionenstrahlprozessen 7.-9. März 2017



### Karsten Harbauer, M. Kölbach, K. Ellmer

# "Charakterisierung von gepulsten Laser-Ablations-Plasmen"











## Warum gepulste Laserablation (PLD) für Materialbibliotheken?

## Merkmale der PLD

- Target-Stöchiometrie ≈ Film-Stöchiometrie
- Hohe Reinheiten (UHV möglich)
- Epitaktische Schichten abscheidbar
- Es können sehr glatte Schichten gewachsen werden

- Niedrige Rate hohe Schichtqualität
- Materialdurchmusterung mit hohem Durchsatz möglich (kombinatorische PLD)



Prinzip Pulsed Laser Deposition





Entstehende Materialbibliotheken

#### PLD – Pulsed Laser Deposition – Laser, Diagnostik



#### **Optical system**

- Große Abbildungslänge für Verkleinerung bis hinunter zu 1:10
- Zusätzlicher Justierlaser  $\lambda = 633 \text{ nm}$
- Zwei mögliche Winkel zur Targetablation (30 and 45 °)



# Sample holder Shutter Target carouse Abb.6 Innerer Aufbau

#### Laser

- Excimerlaser LPXpro210 (KrF,  $\lambda = 248$  nm,  $\tau = 25$  ns, f < 100 Hz, E = 0.8 J),
- Coherent (Göttingen)



#### **Generelle Merkmale**

- UHV Beschichtungssystem für das kombinatorische Material-Screening von komplexen Oxiden und anderen Halbleitern und Katalysatoren für die photoelektrochemische Produktion von chemischen Brennstoffen
- Ionen/plasma-gestützter Beschichtungsprozess
- Polykristalline und epitaktische Schichtabscheidung
- In situ Ausheilung in verschiedenen Gasatmosphären
- Prevac Sonderanlagenbau Rogow (Polen)



#### **UHV-Schleuse**

- Fast pump down (~30min)
- In situ Vortemperung der Substrate möglich
- Magazin for PLD targets und substrates (5 pieces)

#### **Prozesskammer**

- Targetkarusell mit 6 Targets, mit 2" oder 1" Durchmesser
- Basisdruck< 10<sup>-8</sup> Pa
- In situ Beschichtungskontrolle per Quartz Crystal Monitor (QCM)
- Messung der aktuellen Laserleistung
- Transferkammer f
  ür/nach EMIL
- Linear verschiebbares Maskensystem zur Beschichtung mit Schichtdickengradienten
- Variabler Target zu Substrate Abstand (40-100mm)





# **HZB: SOLARE BRENNSTOFFE**

- PLD  $\rightarrow$  Kombinatorik

# **SETUP / MESSMETHODEN:**

- Time of flight (ToF) Messmethode, Faraday probe
- Zeitaufgelöste, bildgebende Plume Anlayse mit iCCD

# VERSUCHE

- ToF: Einflussgrößen wie Targetmaterialien, Gasdruck
- iCCD: Beispiele
- Vergleich der Methoden

# ZUSAMMENFASSUNG + AUSBLICK











### $V_2O_5$ , 4J/cm<sup>2</sup>, ToF-Bias -40V...-5V, Vakuum

### **ToF-Flugzeiten**

- Intensitätsmaximum abhängig von Bias
- − Intensiver UV Lichtpulse löst Elektronen aus ToF Elektrode  $\rightarrow$  [3,4]
- Flugzeitmessung zwischen Lichtpuls und Intensitätsmaximum
- →Lichtpuls nicht immer sichtbar

## Ermittlung der Flugzeit mittels Triggerung durch Laser

 Laufzeit muss korrigiert werden (1,76 µs Nachweis durch Differenz Lichtpuls zu Lasertriggersignal)

[3] B. Toftmann et al. / Applied Surface Science 278 (2013) 273–277
[4] T.N. Hansen, J. Schou, J.G. Lunney, Europhys. Lett. 40, 441 (1997)



4,84

4,60

2,20 2,50

3,12

2,56



4J/cm <sup>2</sup> , ToF-Bias -40V, Vakuum								
/laterial	'Spannung [V]'	Strom [A]	'Flugzeit [µs]'					
BiVO	5,40	0,11	5,40					

22,00

19,60

34,10

11,20

18,70

35,40

0,44

0,39

0,68

0,22

0,37

0,71

- ToF-Zeitverläufe für verschiedene Materialien zum Testen von Methode und Messaufbau
- Plumeformen variieren in Abhängigkeit von Material und Targetzustand (Verbrauchsgrad)



Λ

Bi

BiO

VO

V

Ag

ZnO



#### Umrechnung der ToF-Flugzeitsignale

• Darstellung der kinetischen Energie der Ionen der Masse m aus der PLD-Entladung

$$\Rightarrow E_{kin}[J,Ws] = \frac{m * v^2}{2} = \frac{m}{2} * \left(\frac{s}{t}\right)^2 = \frac{M[amu] * m_u[kg]}{2} * \left(\frac{s[m]}{t[s]}\right)^2$$

 Einsetzen der Zahlenwerte (m<sub>u</sub> = 1,6605 \*10<sup>-27</sup> kg); Abstand s=0.06 m; 1 J=6,242 \*10 <sup>18</sup> eV) ergibt die Zahlenwertgleichung und ersetzt Zeitskala (Abzisse):

$$\Rightarrow E_{kin}[eV] = \frac{1,8657 * 10^{-11} [eV] * M [amu]}{(t - t_{start}) [s]^2}$$

• Die Ordinate Nach Thompson :[5]

$$\Rightarrow I(E) \left[\frac{As}{eV}\right] = 9.648 * 10^6 * (t - t_{start})^3 * \frac{U(t)}{(M * s^2)}$$

[5] M.W. Thompson, B.W. Farmery, P.A. Newson, I. A Mechanical Spectrometer for Analysing the Energy Distribution of Sputtered Atoms of Copper or Gold, Phil. Mag., 18 (1968) 361 376





4J/cm<sup>2</sup>, ToF-Bias -40V, Vakuum

- Vergleichbare Ergebnisse bzgl. Ionenenergieverteilungen, wie in der Literatur
- Max. Ionenergien von 100 bis 400eV
- → höher als Magnetronsputtern

B. Toftmann et al. Applied Surface Science 278 (2013) 273–277





### 4J/cm<sup>2</sup>, ToF-Bias -40V, Vakuum

- Darstellung der metallischen einzelatomaren Stoffe
- Plausible Messergebnisse
- Schultern erkennbar bei Ag, V

Material	amu	'Spannung [V]'	Strom [A]	'Flugzeit [µs]'	∆Hv[kJ/g]
Bi	209	22,00	0,44	4,84	0,50
V	51	11,20	0,22	2,50	8,87
Ag	108	18,70	0,37	3,12	2,32



#### PLD – ToF – Prozessdruck





### 4J/cm<sup>2</sup>, ToF-Bias -40V

Der Hintergrundgasdruck von Ar wurde von Vakuum bis 5\*10<sup>-2</sup> mbar variiert für verschiedene Materialien → Thermalisierung im Gas

### <u>Links</u>: $\rightarrow$ BiVO<sub>4</sub>, Bi, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, V

- zeitliche Messsignalverläufe für ToF Messung
- Zunahme der Flugzeiten und Abnahme Messsignale durch Zunahme der Gasstreuung
   <u>Rechts:</u> →Bi, V
- Umrechnung in Ladungen als Funktion der Ionenenergien (hier nur Einzelelemente)
- Resultierende Abnahme der Ionenenergien gut ersichtlich









 Erster Aufbau mit Mastertrigger durch Pulsgenerator (Tests: f<sub>Trigger</sub> =0,5Hz, t<sub>Puls</sub>=100μs)
 Speicheroszilloskop erfasst Trigger impuls, Gate- und Exposureverhalten der iCCD-Kamera (später auch simultan die ToF Messung)





#### PLD – iCCD Kamera – Targetmaterialien







- ToF + iCCD  $\rightarrow$  V und Bi
- Synchronisierung fehlt noch und einheitlichen Kameraeinstellungen bzw. Farbdarstellung.
- Vanadium in beiden Fällen relativ früheres Auf- und Abklingen der Messsignale



- Direktvergleich: V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zeigt deutlich unterschiedliche ToF-Flugzeiten
- Nutzbarer Effekt zur massenselektiven Untersuchung???



-

HZ

elmholtz

**Zentrum Berlin** 



## Targetablation: Verhindern der Strukturausbildung auf dem Target







- Scan nur über Radius → Ausbildung entgegen dem Lasereinfall (Abdampfen der Bi-Komponente)
- Techn. Gegenmaßnahme → Scannen über den gesamten Durchmesser
- Verwendbarkeit der ToF-Messung zur Kontrolle dieses Phänomens? → Erhalt der Stöchiometrie



### **Formation of cones:**

BiVO<sub>4</sub>-Target,  $F= 1 \text{ J/cm}^2$ , 5 - 500 shots on fixed target







#### Die ToF- Methode ist eine einfache und schnelle Methode zur Messung von Ionenenergien:

- Flugzeiten zwischen **3 und 6µs**
- Die Materialien BiVO<sub>4</sub>, Bi, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, V, Ag, ZnO wurden bei Drücken von Vakuum bis 5\*10<sup>-</sup>
   <sup>2</sup>mbar verglichen
- Maximale Energien für die untersuchten Materialien liegen zwischen **100 und 400eV**
- Zusammenhang von Atommassen auf ToF-Flugzeiten
- Thermalisierung klar erkennbar bei der Druckvariation
- Inbetriebnahme und Untersuchungen des Plumes mit der ICCD Kamera
  - Erste plausible Bilder wurden für **BiVO**<sub>4</sub>, **Bi**, **Bi**<sub>2</sub>**O**<sub>3</sub>, **V**<sub>2</sub>**O**<sub>5</sub>, **V** aufgenommen
  - Auswertung der ersten Aufnahmen noch nicht abgeschlossen
  - Handhabung der Kamera ist noch zu verbessern
  - Aufbau für eine genauere **Zeitmessung** in Vorbereitung
- Ausblick:
  - Elementspezifische Beobachtungen unter Verwendung von Interferenzfiltern



## Karsten.Harbauer@helmholtz-berlin.de





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

IV. Erfahrungsaustausch Mühlleithen